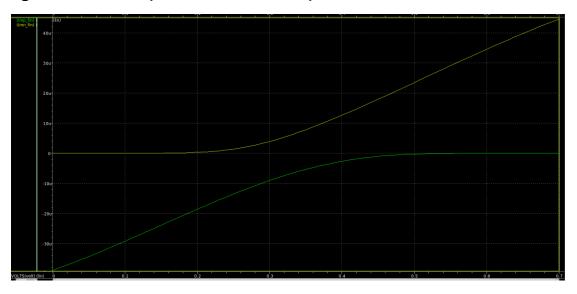
DIC HW1

312510190 張家瑋

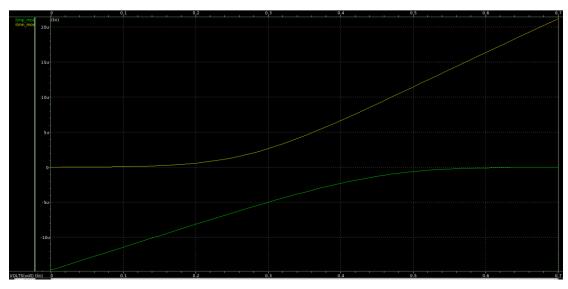
Exercise 1-1: DC characteristics

1. Vgs-IDS of FinFET (N-FinFET & P-FinFET)



由上圖可發現,N-FinFET 的電流隨著 VG 的增加而漸增,P-FinFET 的電流 隨著 VG 的增加而漸減

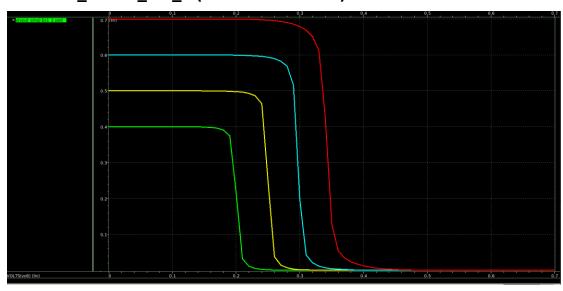
2. Vgs-IDS of CMOS (NMOS & P-MOS)



由上圖可發現,NMOS 的電流隨著 VG 的增加而漸增,PMOS 的電流隨著 VG 的增加而漸減; 此外 CMOS 的電流較 FinFET 小

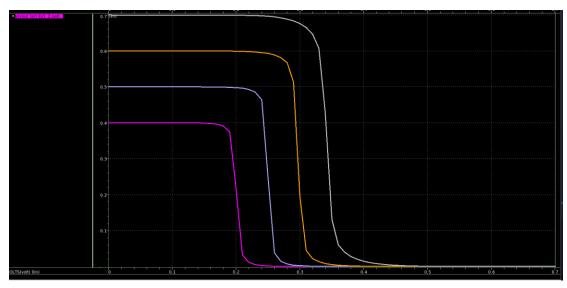
Exercise 1-2: Voltage Transfer Curve

1-1. INVx1_ASAP7_75t_R (smallest inverter)



當 Vdd 由 0.4V 增加至 0.7V, Vout 在 Vin 為低電位時的電位會變大 (VTC 往外擴張)

1-2. INVx13_ASAP7_75t_R (largest inverter)



由上圖得知,當 Vdd 由 0.4V 增加至 0.7V, Vout 在 Vin 為低電位時的電位會變大 (VTC 往外擴張),比較兩圖得 Inverter 大小改變 VTC 變化不大

```
*** MOS Inverter ***

Mp_INV_MOS Vout_MOS Vin VDD VDD pmos w=32n l=16n

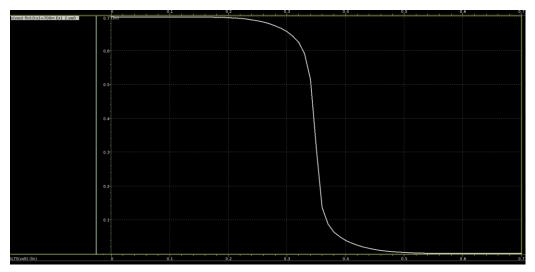
Mn_INV_MOS Vout_MOS Vin GND GND nmos w=16n l=16n

*** FIN Inverter ***

Mp_INV_FIN Vout_FIN Vin VDD VDD pmos_lvt nfin=3

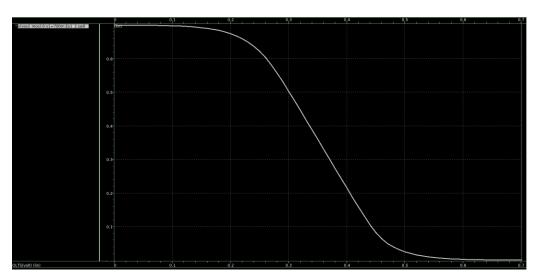
Mn_INV_FIN Vout_FIN Vin GND GND nmos_lvt nfin=2
```

2-1. FinFET Inverter



設定 PMOS 的寬度設為 NMOS 的兩倍,使成為 unit-sized inverter, 並 threshold voltage 為 0.35V,VTC 在 V=0.35 時迅速下降

2-2. CMOS Inverter



設定 FinFET 的部分,P-FinFET 的 nfin 設為 N-FinFET 的 1.5 倍,使成為 unit-sized inverter, 並 threshold voltage 為 0.35V,VTC 會經過 (0.35,0.35)

Exercise 1-3: Power consumption

1. Measure the power consumption of the inverters, designed in 1-2

設定方波,頻率分別為 1GHz、2GHz 及 4GHz。

```
.subckt inv_fin in out

Mp out in VDD x pmos_rvt m=5

Mn out in GND x nmos_rvt m=4
.ends

.subckt inv_mos in out

Mp out in VDD x pmos W=32nm L=16nm

Mn out in GND x nmos W=16nm L=16nm
.ends

.subckt fo4_fin in
    cload_ff in gnd 10f
    xinv_fin1 in fo_ff1 inv_fin
    xinv_fin2 in fo_ff2 inv_fin
    xinv_fin4 in fo_ff4 inv_fin
.ends

.subckt fo4_mos in
    cload_mos in gnd 10f
    xinv_mos1 in fo_mos1 inv_mos
    xinv_mos2 in fo_mos3 inv_mos
    xinv_mos4 in fo_mos4 inv_mos
.ends
```

利用 subcir 將 out loading 設為 FO4(4 inverter) + 10fF 的形式,再將 finfet/mos 串進來,計算 power 可得到下圖結果。

```
.title dc power
***** transient analysis thom= 25.000 temp= 25.000 ******
                                                                to= 30.0000n
average_power_mos_1g= 4.3006u from=
                                               0.
average_power_ff_1g= 6.1282u from=
                                               0.
                                                                to= 30.0000n
average_power_mos_2g= 5.4691u from=
average_power_ff_2g= 12.2456u from=
average_power_mos_4g= 5.8140u from=
                                               0.
                                                                 to= 30.0000n
                                               0.
                                                                to= 30.0000n
                                                                to= 30.0000n
to= 30.0000n
                                               0.
average_power_ff_4g= 24.1586u from=
                                               0.
          ***** job concluded
```

Mos (1G)	4.3006 uW
Finfet (1G)	6.1282 uW
Mos (2G)	5.4691 uW
Finfet (2G)	12.2456 uW
Mos (4G)	5.8140 uW
Finfet (4G)	24.1586 uW

Exercise 1-4: Characteristics of NOR2/NAND2

1. NOR2x1_ASAP7_75t_R (smallest NOR)

tf_nor= 96.5772p targ= 3.0684n trig= 2.9718n tr_nor= 4.1259n targ= 9.1004n trig= 4.9745n tphl_nor= 63.8618p targ= 3.0139n trig= 2.9500n tplh_nor= 75.6182p targ= 5.0256n trig= 4.9500n

Tf	96.5772 ps
Tr	4125.9 ps
Tphl	63.8618 ps
Tplh	75.6182 ps

量測方式:

Tf	Output 第一次降至 0.7V * 0.1 的時間 - Output 第一
	次降至 0.7V * 0.9 的時間
Tr	Output 第一次升至 0.7V * 0.9 的時間 - Output 第一
	次升至 0.7V * 0.1 的時間
Tphl	Output 第一次降至 0.7V * 0.5 的時間 - Input 第一次
	升至 0.7V * 0.5 的時間
Tplh	Output 第一次升至 0.7V * 0.5 的時間 - Input 第一次
	降至 0.7V * 0.5 的時間



2. NAND2x1_ASAP7_75t_R (smallest NAND)

tf_nand= 90.4043p targ= 7.0597n trig= 6.9693n tr_nand= 67.9271p targ= 9.0388n trig= 8.9708n tphl_nand= 58.6100p targ= 7.0086n trig= 6.9500n tplh_nand= 51.5387p targ= 9.0015n trig= 8.9500n

Tf	90.4043 ps
Tr	67.9271 ps
Tphl	58.6100 ps
Tplh	51.5387 ps

量測方式:

Tf	Output 第一次降至 0.7V * 0.1 的時間 - Output 第一
	次降至 0.7V * 0.9 的時間
Tr	Output 第一次升至 0.7V * 0.9 的時間 - Output 第一
	次升至 0.7V * 0.1 的時間
Tphl	Output 第一次降至 0.7V * 0.5 的時間 - Input 第一次
	升至 0.7V * 0.5 的時間
Tplh	Output 第一次升至 0.7V * 0.5 的時間 - Input 第一次
	降至 0.7V * 0.5 的時間

